

日程表 (会場別) 1

北海道大学

会場名	収容人数	9月17日 (水)		9月18日 (木)		9月19日 (金)		9月20日 (土)			
		午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後		
A (高等教育)	A1 大講堂	450		12.5 有機太陽電池	12.5 有機太陽電池	バイオマテリアル表面の マイクロナノの挙動とその 応用	12.5 有機太陽電池	12.5 有機太陽電池			
	A2 N1	110	チュートリアル「半導体 デバイス:物性の基礎から デバイスの原理,回路 システムまで」	12.2 評価・基礎物性	12.2 評価・基礎物性	12.2 評価・基礎物性	12.7 医用工学・バイオ チップ	12.7 医用工学・バイオ チップ	12.7 医用工学・バイオ チップ	12.7 医用工学・バイオ チップ	
	A3 N2	110	12.3 機能材料・萌芽的 デバイス	12.3 機能材料・萌芽的 デバイス	12.3 機能材料・萌芽的 デバイス	12.3 機能材料・萌芽的 デバイス	12.6 ナノバイオテクノ ロジー	12.6 ナノバイオテクノ ロジー	12.6 ナノバイオテクノ ロジー		
	A4 E201	140	12.4 有機EL・トラン ジスタ	12.4 有機EL・トランジ スタ	12.4 有機EL・トランジ スタ	12.4 有機EL・トランジ スタ	Innovation in R&D of the Flexible Electronics -Toward the Inorganic Flexible Devices-	Innovation in R&D of the Flexible Electronics -Toward the Inorganic Flexible Devices-	12.4 有機EL・トランジ スタ	12.4 有機EL・トランジ スタ	
	A5 E204	70	12.1 作製・構造制御	12.1 作製・構造制御	12.1 作製・構造制御		12.4 有機EL・トランジ スタ	12.4 有機EL・トランジ スタ			
	A6 E205	70	6.5 表面物理・真空	6.5 表面物理・真空	9.2 ナノワイヤ・ナノ粒 子	9.2 ナノワイヤ・ナノ粒 子	9.2 ナノワイヤ・ナノ粒 子	9.5 新機能材料・新物性			
	A7 E206	70	12.7 医用工学・バイオ チップ		9.4 熱電変換	9.4 熱電変換	9.3 ナノエレクトロニク ス	9.3 ナノエレクトロニク ス			
	A8 E207	70	6.2 カーボン系薄膜	6.2 カーボン系薄膜	6.2 カーボン系薄膜	6.2 カーボン系薄膜	6.6 プローブ顕微鏡	6.6 プローブ顕微鏡			
	A9 E208	116	チュートリアル「放射光 計測の基礎と実際」	チュートリアル「半導体 バイオメディカルデバイ ス技術」	6.1 強誘電体薄膜, 9.1 誘電材料・誘電体のコー ドシェアセッション	6.1 強誘電体薄膜, 9.1 誘電材料・誘電体のコー ドシェアセッション	6.1 強誘電体薄膜, 9.1 誘電材料・誘電体のコー ドシェアセッション	6.1 強誘電体薄膜, 9.1 誘電材料・誘電体のコー ドシェアセッション			
	A10 E214	116	6.3 酸化物エレクトロニ クス	6.3 酸化物エレクトロニ クス	6.3 酸化物エレクトロニ クス	6.3 酸化物エレクトロニ クス	6.3 酸化物エレクトロニ クス	6.3 酸化物エレクトロニ クス	6.3 酸化物エレクトロニ クス	6.3 酸化物エレクトロニ クス	
	A11 E215	70		6.4 薄膜新材料	6.4 薄膜新材料	6.4 薄膜新材料					
	A12 E301	140	チュートリアル「結晶成 長」	14.5 化合物太陽電池, 15.2 II-VI 族結晶および 多元系結晶のコードシェ アセッション	合同セッションK ワイ ドギャップ酸化物半導体 材料・デバイス	合同セッションK ワイ ドギャップ酸化物半導体 材料・デバイス	合同セッションK ワイ ドギャップ酸化物半導体 材料・デバイス	合同セッションK ワイ ドギャップ酸化物半導体 材料・デバイス	合同セッションK ワイ ドギャップ酸化物半導体 材料・デバイス	合同セッションK ワイ ドギャップ酸化物半導体 材料・デバイス	
	A13 E304	70	X線反射率, 表面X線散 乱による埋もれた界面の 解析における位相問題 - 新光源への期待	X線反射率, 表面X線散 乱による埋もれた界面の 解析における位相問題 - 新光源への期待	7.5 ビーム・光助起表面 反応 7.8 ビーム応用一般・新 技術	原子・分子ビームによる 表面反応制御とその応用 展開		7.1 X線技術		7.4 ナノインプリント	7.4 ナノインプリント
	A14 E305	70	7.3 リソグラフィ	界面ナノ電子化学: 半導 体ウェットプロセスの最 前線			7.6 イオンビーム一般	7.2 電子顕微鏡, 評価, 測定, 分析	7.7 微小電子源		
	A15 E306	70			13.5 Si-English Session	1.8 超音波		13.1 基礎物性・表面界 面現象・シミュレーショ ン	13.1 基礎物性・表面界 面現象・シミュレーショ ン		
	A16 E307	70		13.4 デバイス/集積化 技術	13.4 デバイス/集積化 技術	13.4 デバイス/集積化 技術	15.5 IV 族結晶, IV-IV 族混晶	15.5 IV 族結晶, IV-IV 族混晶			
	A17 E308	116	15.6 IV 族系化合物	15.6 IV 族系化合物	15.6 IV 族系化合物	15.6 IV 族系化合物	13.2 絶縁膜技術	13.2 絶縁膜技術	15.1 パルク結晶成長	15.1 パルク結晶成長	
	A18 E310	140			3.15 シリコンフォトニ クス	3.15 シリコンフォトニ クス	3.15 シリコンフォトニ クス	放射光表面反応観察の新 展開			
	A19 E311	116	チュートリアル「鉄系超 伝導体-物質と物性-」	絶縁膜上におけるIV族系 半導体結晶薄膜の低温成 長 新しい結晶成長技術 への期待	13.3 Si プロセス・配線・ MEMS・集積化技術	13.3 Si プロセス・配線・ MEMS・集積化技術	13.3 Si プロセス・配線・ MEMS・集積化技術	13.3 Si プロセス・配線・ MEMS・集積化技術	13.3 Si プロセス・配線・ MEMS・集積化技術	13.3 Si プロセス・配線・ MEMS・集積化技術	
	A20 E312	70	11.5 接合, 回路作製プ ロセスおよびデジタル応 用	11.5 接合, 回路作製プ ロセスおよびデジタル応 用	15.3 III-V 族 エピタキ シャル結晶	15.7 エピタキシーの基礎 15.3 III-V 族 エピタキ シャル結晶	11.2 薄膜, 厚膜, テー プ作製プロセスおよび結 晶成長	11.2 薄膜, 厚膜, テー プ作製プロセスおよび結 晶成長	15.8 結晶評価, 不純物・ 結晶欠陥		
	A21 E313	70		11.3 磁界電流, 超伝導 パワー応用		11.1 基礎物性	11.1 基礎物性	11.1 基礎物性			
	A22 E314	70			14.3 電子デバイス・プ ロセス技術	14.3 電子デバイス・プ ロセス技術	11.4 アナログ応用およ び関連技術	11.4 アナログ応用およ び関連技術	11.4 アナログ応用およ び関連技術	11.4 アナログ応用およ び関連技術	
	A23 E315	70	1.1 応用物理一般・学際 領域	1.3 新技術・複合新領域		学生の育成を兼ねた科学 啓発活動	1.4 エネルギー変換・貯 蔵	応用物理に期待される資 源リサイクルとエネル ギー問題			
	A24 E317	70			14.4 光物性・発光デバ イス	1.6 磁場応用	1.5 資源・環境	1.7 計測技術・計測標準			
	A25 E318	70		薄膜シリコン太陽電池技 術の現状と課題	16.3 シリコン系太陽電池	16.3 シリコン系太陽電池	16.3 シリコン系太陽電池	16.3 シリコン系太陽電池	16.3 シリコン系太陽電池	16.3 シリコン系太陽電池	
	A26 E319	70			16.1 基礎物性・評価	16.1 基礎物性・評価	14.4 光物性・発光デバ イス	14.4 光物性・発光デバ イス	14.4 光物性・発光デバ イス	14.4 光物性・発光デバ イス	
	A27 N302	90	14.3 電子デバイス・プ ロセス技術, 15.4 III-V 族窒化物結晶のコード シェアセッション	14.3 電子デバイス・プ ロセス技術, 15.4 III-V 族窒化物結晶のコード シェアセッション	14.2 超薄膜・量子ナノ 構造	14.2 超薄膜・量子ナノ 構造	14.2 超薄膜・量子ナノ 構造	14.1 探索的材料物性	14.1 探索的材料物性		
	A28 N304	90		14.5 化合物太陽電池	14.5 化合物太陽電池	14.5 化合物太陽電池	14.5 化合物太陽電池				
S (S棟)	S1 S1	250	Japan-Korea Joint Symposium on Semiconductor Physics and Technology - Nano-carbon materials including graphene - (日韓共同シンポジウム - グラフェン等のナノカ ボン材料 -)	Japan-Korea Joint Symposium on Semiconductor Physics and Technology - Nano-carbon materials including graphene - (日韓共同シンポジウム - グラフェン等のナノカ ボン材料 -)	8. プラズマエレクトロニ クス受賞記念講演	コンピュータによるプラ ズマシミュレーションの 実際 (いま, 何をどこま で計算できるのか)	14.5 化合物半導体, 15.3 III-V 族 エピタキ シャル結晶, 15.4 III-V 族窒化物結晶のコード シェアセッション				
	S2 S2	346	10.1 新物質創成 (酸化物・ ホイスラー・金属磁性 体等) (ショート口頭 講演付ポスター講演)	10.1 新物質創成 (酸化物・ ホイスラー・金属磁性 体等) (ショート口頭 講演付ポスター講演)	10.1 新物質創成 (酸化物・ ホイスラー・金属磁性 体等)	スピントロニクス材料・ デバイスの最前線	10.3 GMR・TMR・磁気 記録技術	10.4 半導体・有機・光・ 量子スピントロニクス	10.2 スピントルク・ス ピン流・回路・測定技術	10.2 スピントルク・ス ピン流・回路・測定技術	

日程表 (会場別) 2

北海道大学

会場名	収容人数	9月17日(水)		9月18日(木)		9月19日(金)		9月20日(土)		
		午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後	
S (S棟)	S8 S8	70	3.8 光計測技術・機器	3.8 光計測技術・機器	3.8 光計測技術・機器	3.8 光計測技術・機器	8.1 プラズマ生成・制御 8.6 プラズマ現象・新応用・融合分野	8.1 プラズマ生成・制御 8.6 プラズマ現象・新応用・融合分野	8.6 プラズマ現象・新応用・融合分野	8.6 プラズマ現象・新応用・融合分野
	S9 S9	70	3.7 レーザープロセシング	3.7 レーザープロセシング	3.7 レーザープロセシング	3.7 レーザープロセシング	8.3 プラズマ成膜・表面処理	8.3 プラズマ成膜・表面処理	8.5 プラズマナノテクノロジー	8.5 プラズマナノテクノロジー
	S10 S10	70	8. プラズマエレクトロニクス 英語セッション	8. プラズマエレクトロニクス 海外研究者招待講演 8. プラズマエレクトロニクス 英語セッション				8.4 プラズマエッチング	10.4 半導体・有機・光子デバイスエレクトロニクス	
	S11 S11	70		8.2 プラズマ診断・計測			3.3 情報フォトリソグラフィ	3.3 情報フォトリソグラフィ		
B (フロンティア)	B1 セミナー1	105	17.4 デバイス応用	17.4 デバイス応用 17.2 構造制御・プロセス		17.3 新機能探索・基礎物性評価	17.4 デバイス応用	17.2 構造制御・プロセス 17.3 新機能探索・基礎物性評価	17.1 成長技術	
	B2 セミナー2	87		2.1 放射線物理一般・検出器基礎	2.3 放射線応用・発生装置・新技術	2.2 検出器開発	2.2 検出器開発	原子力発電所事故時に於ける核燃料・核分裂生成物の挙動及び廃止措置に向けた取り組み	2.2 検出器開発	2.2 検出器開発
	B3 ホール	256	本部分行事 (詳細は p.7 参照)	本部分行事 (詳細は p.7 参照)	応用物理学学会会長特別講演 (詳細は p.18 参照)	機能性原子薄膜化合物材料の新展開	17.1 成長技術	17.1 成長技術	17.1 成長技術	
C (工学部)	C1 B11	78	3.12 ナノ領域光科学・近接場光学	3.12 ナノ領域光科学・近接場光学	3.12 ナノ領域光科学・近接場光学	3.12 ナノ領域光科学・近接場光学	3.1 光学基礎・光学新領域	3.1 光学基礎・光学新領域	18.5 Opto-electronics	18.5 Opto-electronics
	C2 B12	72			3.10 量子物理・技術	3.10 量子物理・技術	3.6 超高速・高強度レーザー	3.6 超高速・高強度レーザー	3.6 超高速・高強度レーザー	
	C3 B31	84	18.8 Carbon Photonics	18.8 Carbon Photonics	18.4 Optical Microsensing, Manipulation, and Fabrications	18.4 Optical Microsensing, Manipulation, and Fabrications	18.1 Plasmonics	18.1 Plasmonics	18.1 Plasmonics	
	C4 B32	84	18.7 Laser Photonics: XFEL and ultrafast optics -	OSA President Special Lecture 18.7 Laser Photonics: XFEL and ultrafast optics -	18.2 Bio- and Medical Photonics	18.2 Bio- and Medical Photonics	18.2 Bio- and Medical Photonics	18.3 Laser Manufacturing	18.6 Information Photonics	18.6 Information Photonics
	C5 オープンホール	364	15.4 III-V 族窒化物結晶	15.4 III-V 族窒化物結晶	15.4 III-V 族窒化物結晶	15.4 III-V 族窒化物結晶	窒化物半導体特異構造の科学～物性評価と結晶学の構築へ～	窒化物半導体特異構造の科学～物性評価と結晶学の構築へ～	15.4 III-V 族窒化物結晶	15.4 III-V 族窒化物結晶
	C6 C212	104	3.13 半導体光デバイス	3.13 半導体光デバイス	3.13 半導体光デバイス	3.13 半導体光デバイス	3.9 テラヘルツ全般	3.9 テラヘルツ全般	3.9 テラヘルツ全般	3.9 テラヘルツ全般
	C7 C213	104	3.2 材料・機器光学	3.2 材料・機器光学	3.14 光制御デバイス・光ファイバ	3.14 光制御デバイス・光ファイバ	3.14 光制御デバイス・光ファイバ	量子計測技術における新展開	3.4 生体・医用光学	3.4 生体・医用光学
	C8 C310	72		3.11 フォトリソグラフィ・現象	3.11 フォトリソグラフィ・現象	3.11 フォトリソグラフィ・現象	3.5 レーザー装置・材料 3.14 光制御デバイス・光ファイバのコードシェアセッション	3.5 レーザー装置・材料	3.5 レーザー装置・材料	3.5 レーザー装置・材料
PA (第1体育館)	PA1 PA8		12.2 評価・基礎物性 12.5 有機太陽電池 13.4 デバイス/集積化技術	[前半] 13.3 Si プロセス・配線・MEMS・集積化技術 [後半] 3.11 フォトリソグラフィ・現象 3.15 シリコンフォトリソグラフィ 6.1 強誘電体薄膜, 9.1 誘電材料・誘電体のコードシェアセッション K ワイドギャップ酸化半導体材料・デバイス	12.6 ナノバイオテクノロジー 12.7 医用工学・バイオチップ 17. ナノカーボン	[前半] 3.2 材料・機器光学 3.3 情報フォトリソグラフィ 3.5 レーザー装置・材料 3.6 超高速・高強度レーザー 3.9 テラヘルツ全般 [後半] 2. 放射線 6.3 酸化物エレクトロニクス 6.6 プローブ顕微鏡	1.3 新技術・複合新領域 1.7 計測技術・計測標準 1.8 超音波 3.4 生体・医用光学 3.7 レーザープロセシング 3.8 光計測技術・機器 3.10 量子物理・技術 3.13 半導体光デバイス	[前半] 3.14 光制御デバイス・光ファイバ 7.5 ビーム・光励起表面反応 7.6 イオンビーム一般 [後半] 9.2 ナノワイヤ・ナノ粒子 9.4 熱電変換 12.3 機能材料・萌芽的デバイス 12.4 有機EL・トランジスタ	3.1 光学基礎・光学新領域 13.1 基礎物性・表面界面現象・シミュレーション 13.2 絶縁膜技術	1. 講演につき、たて180cm、よこ90cmのパネルが用意されています。予め講演番号、講演題目、所属、氏名を記入した用紙(たて15cm、よこ85cm)を各自が用意し、これをパネル上部に取り付けてください。
	PB (第2体育館)	PB1 PB12		8.1 プラズマ生成・制御 8.6 プラズマ現象・新応用・融合分野 16.1 基礎物性・評価 16.3 シリコン系太陽電池	[前半] 9.3 ナノエレクトロニクス 9.5 新機能材料・新物性 [後半] 10. スピントロニクス・マグネティクス	1.1 応用物理一般・学際領域 1.2 教育 1.3 新技術・複合新領域 1.4 エネルギー変換・貯蔵 1.5 資源・環境 11. 超伝導	[前半] 7.1 X線顕微鏡、評価、測定、分析 7.3 リソグラフィ 8.2 プラズマ診断・計測 8.3 プラズマ成膜・表面処理 8.4 プラズマエッチング 8.5 プラズマナノテクノロジー 14.4 光物性・発光デバイス 15.1 ハルクリン成長 15.5 IV 族結晶, IV-IV 族混晶 [後半] 3.12 ナノ領域光科学・近接場光学 12.1 作製・構造制御	6.2 カーボン系薄膜 6.4 薄膜新材料 6.5 表面物理・真空 14.1 探索的材料物性 15.6 IV 族系化合物	[前半] 14.2 超薄膜・量子ナノ構造 14.3 電子デバイス・プロセス技術 14.5 化合物太陽電池 [後半] 15.2 II-VI 族結晶および多元系結晶 15.3 III-V 族エピタキシャル結晶 15.4 III-V 族窒化物結晶 15.8 結晶評価、不純物・結晶欠陥	・次にパネルに、各自が用意したポスター、図表、写真などを、適宜レイアウト(例えば研究目的、研究方法、研究成果といった順に)して掲示してください。 ・ポスターの大きさ、形式は問いませんが、できるだけ見やすく、大きく書いてください。その際ポスターがパネルにうまく収まるように、予めポスターの割り付けを検討しておくと便利です。 ・すべての掲示は本部で用意したピンで行ってください。糊の使用はご遠慮ください。